



10 GHz ~ 20 GHz GaAs MMIC 二重平衡ミキサー

HMC554ALC3B

データシート

特長

変換損失: 8.5 dB

LO/Rf アイソレーション: 37 dB

入力 IP3: 20 dBm

RoHS 準拠、2.90 mm x 2.90 mm 12 端子 LCC パッケージ

アプリケーション

マイクロ波無線および超小型地上局 (VSAT) 無線

試験装置

防衛用レーダー (EW)、電子対抗手段 (ECM)、および指揮、
統制、通信、情報 (C3I)

概要

HMC554ALC3B は汎用二重平衡ミキサーで、リードレスの RoHS 準拠 LCC パッケージを採用しており、10 GHz ~ 20 GHz のアップコンバータまたはダウンコンバータとして使用することができます。このミキサーは、ガリウム・ヒ素 (GaAs) 金属半導体電界効果トランジスタ (MESFET) プロセスで製造されており、外付け部品やマッチング回路が不要です。

機能ブロック図

HMC554ALC3B

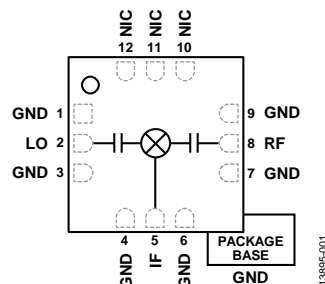


図 1.

HMC554ALC3B はバラン構造が最適化されているため、局部発振器 (LO) と無線周波数 (RF) および LO と中間周波数 (IF) のアイソレーションが優れています。RoHS 準拠の HMC554ALC3B はワイヤ・ボンディングが不要で、量産向け表面実装方法に適しています。

目次

特長	1	ダウンコンバータの性能、IF = 3000 MHz.....	10
アプリケーション.....	1	アップコンバータの性能、IF _{IN} = 100 MHz.....	13
機能ブロック図.....	1	アップコンバータの性能、IF _{IN} = 3000 MHz.....	16
概要	1	アイソレーションおよびリターン・ロス.....	19
改訂履歴	2	IF 帯域幅 - ダウンコンバータ	21
仕様	3	スプリアスおよび高調波性能.....	23
絶対最大定格.....	4	動作原理.....	24
熱抵抗	4	アプリケーション情報.....	25
ESD に関する注意	4	代表的なアプリケーション回路.....	25
ピン配置およびピン機能説明.....	5	評価用 PCB の情報.....	25
インターフェース回路図.....	5	外形寸法.....	26
代表的な性能特性.....	6	オーダー・ガイド	26
ダウンコンバータの性能、IF = 100 MHz	6		

改訂履歴

4/2018—Revision 0: Initial Version

仕様

$T_A = 25\text{ }^\circ\text{C}$ 、 $IF = 100\text{ MHz}$ 、 $LO = 13\text{ dBm}$ 、上側波帯。特に指定のない限り、すべての測定は評価用プリント基板（PCB）を使用しダウンコンバータとして行われています。

表 1.

Parameter	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
FREQUENCY					
RF Pin		10		20	GHz
IF Pin		DC		6	GHz
LO Pin		10		20	GHz
LO AMPLITUDE					
		9	13	15	dBm
10 GHz to 20 GHz PERFORMANCE					
Downconverter					
Conversion Loss			8.5	11.5	dB
Single Sideband Noise Figure	SSB NF		9.5		dB
Input Third-Order Intercept	IP3	19	20		dBm
Input 1 dB Compression Point	P1dB		21		dBm
Input Second-Order Intercept	IP2		46		dBm
Upconverter					
Conversion Loss	IF_{IN}		7		dB
Input Third-Order Intercept	IP3		19.5		dBm
Input 1 dB Compression Point	P1dB		10		dBm
Isolation					
RF to IF		24	41		dB
LO to RF		25	37		dB
LO to IF		23	41		dB
12 GHz to 16 GHz PERFORMANCE					
Downconverter					
Conversion Loss			8		dB
Single Sideband Noise Figure	SSB NF		9		dB
Input Third-Order Intercept	IP3	16	19.5		dBm
Input 1 dB Compression Point	P1dB		20		dBm
Input Second-Order Intercept	IP2		45		dBm
Upconverter					
Conversion Loss	IF_{IN}		6.5		dB
Input Third-Order Intercept	IP3		18		dBm
Input 1 dB Compression Point	P1dB		10		dBm

絶対最大定格

表 2.

Parameter	Rating
RF Input Power	25 dBm
LO Input Power	26 dBm
IF Input Power	25 dBm
IF Source/Sink Current	3 mA
Reflow Temperature	260°C
Maximum Junction Temperature	175°C
Continuous Power Dissipation, P_{DISS} ($T_A = 85^\circ\text{C}$, Derate 3.7 mW/°C Above 85°C)	333 mW
Operating Temperature Range	-40°C to +85°C
Storage Temperature Range	-65°C to +150°C
Electrostatic Discharge (ESD) Sensitivity	
Human Body Model (HBM)	250 V; Class 0B
Field Induced Charged Device Model (FICDM)	1250 V; Class IV

上記の絶対最大定格を超えるストレスを加えると、デバイスに恒久的な損傷を与えることがあります。この規定はストレス定格のみを指定するものであり、この仕様の動作のセクションに記載する規定値以上でのデバイス動作を定めたものではありません。デバイスを長時間にわたり絶対最大定格状態に置くと、デバイスの信頼性に影響を与えることがあります。

熱抵抗

熱性能は、PCB の設計と動作環境に直接関連します。PCB の熱設計には細心の注意が必要です。

θ_{JA} は、1 立方フィートの密閉容器内で測定される、周囲温度とジャンクション温度の間の熱抵抗です。 θ_{JC} は、ジャンクション温度とケース温度の間の熱抵抗です。

表 3. 熱抵抗

Package Type	θ_{JA}	θ_{JC}	Unit
E-12-4 ¹	120	195	°C/W

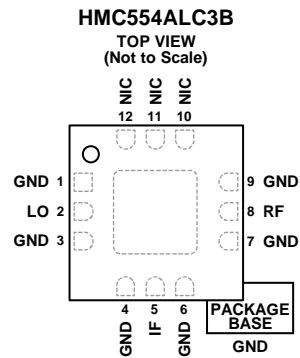
¹ 試験条件 1: JEDEC 規格 JESD51-2 を参照。

ESD に関する注意

**ESD（静電放電）の影響を受けやすいデバイスです。**

電荷を帯びたデバイスや回路ボードは、検知されないまま放電することがあります。本製品は当社独自の特許技術である ESD 保護回路を内蔵してはいますが、デバイスが高エネルギーの静電放電を被った場合、損傷を生じる可能性があります。したがって、性能劣化や機能低下を防止するため、ESD に対する適切な予防措置を講じることをお勧めします。

ピン配置およびピン機能説明



- NOTES
1. NOT INTERNALLY CONNECTED. THESE PINS CAN BE CONNECTED TO RF/DC GROUND. PERFORMANCE IS NOT AFFECTED.
 2. EXPOSED PAD. THE EXPOSED PAD MUST BE CONNECTED TO RF/DC GROUND.

13895-002

図 2. ピン配置

表 4. ピン機能の説明

ピン番号	記号	説明
1, 3, 4, 6, 7, 9	GND	グラウンド。これらのピンとパッケージ裏面は RF/DC グラウンドに接続されていることが必要です。
2	LO	局部発振器ポート。このピンは AC カップリングされ、50 Ω に整合されています。
5	IF	中間周波数ポート。このピンは DC 結合です。DC まで動作させる必要のないアプリケーションでは、必要な IF 周波数範囲を通過させるように値を選択したコンデンサを直列に外付けして、このポートの DC 成分をブロックします。DC まで動作させる場合は、このピンで 3 mA を超える電流をソースまたはシンクすることのないようにしてください。ダイが機能しなくなったり損傷するおそれがあります。
8	RF	無線周波数ポート。このピンは AC カップリングされ、50 Ω に整合されています。
10, 11, 12	NIC EPAD	内部では未接続。このピンは RF/DC グラウンドに接続しても構いません。性能には影響しません。露出パッド。RF または DC グラウンドに接続してください。

インターフェース回路図



図 3. GND インターフェース回路図

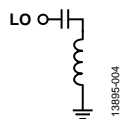


図 4. LO インターフェース回路図

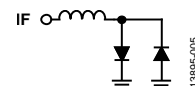


図 5. IF インターフェース回路図

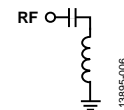


図 6. RF インターフェース回路図

代表的な性能特性

ダウンコンバータの性能、IF = 100 MHz

上側波帯 (ローサイド LO)

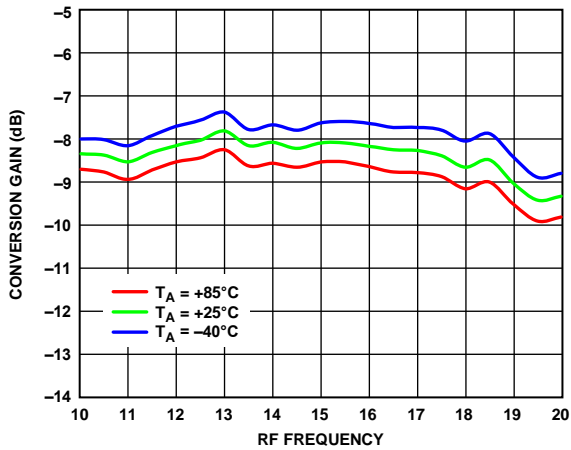


図 7. さまざまな温度での変換ゲインと RF 周波数の関係 (LO = 13 dBm)

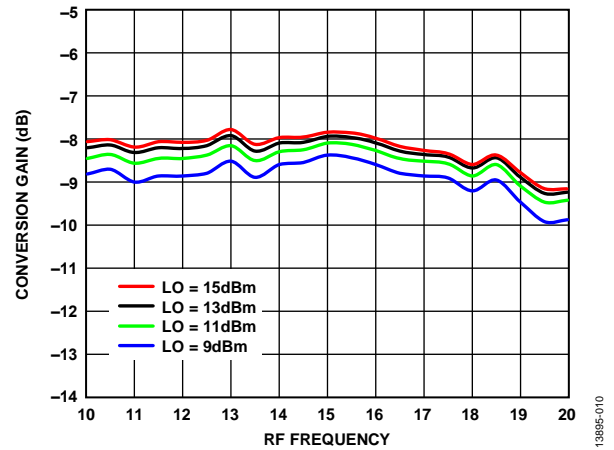


図 10. さまざまな LO パワー・レベルでの変換ゲインと RF 周波数の関係 ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

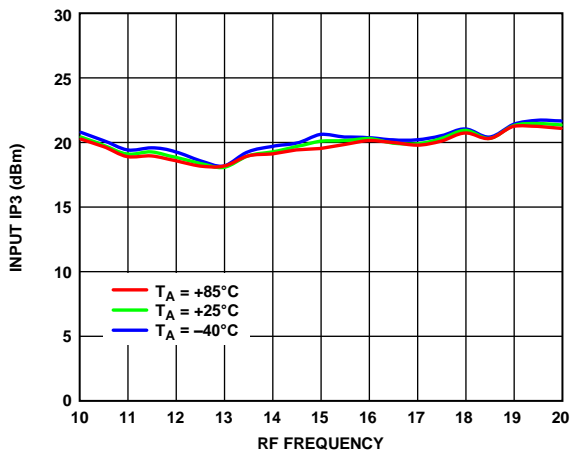


図 8. さまざまな温度での入力 IP3 と RF 周波数の関係 (LO = 13 dBm)

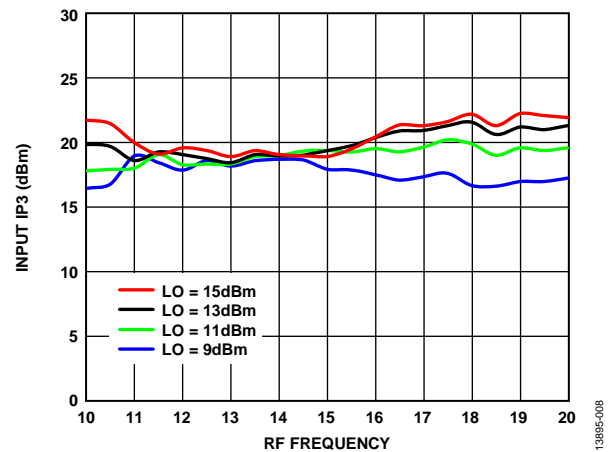


図 11. さまざまな LO パワー・レベルでの入力 IP3 と RF 周波数の関係 ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

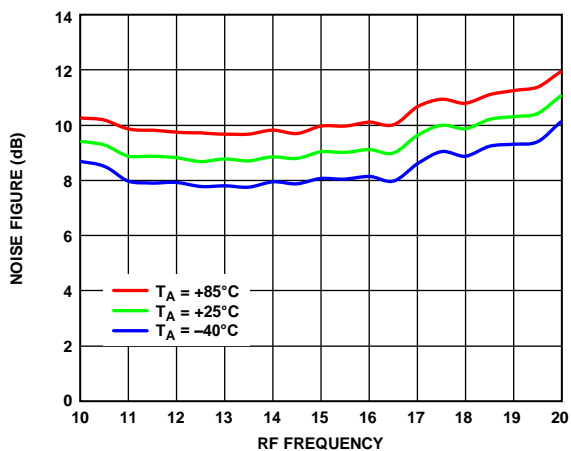


図 9. さまざまな温度でのノイズ指数と RF 周波数の関係 (LO = 13 dBm)

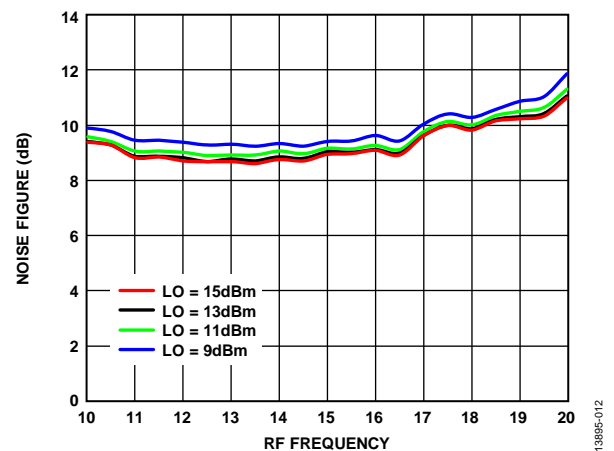


図 12. さまざまな LO パワー・レベルでのノイズ指数と RF 周波数の関係 ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

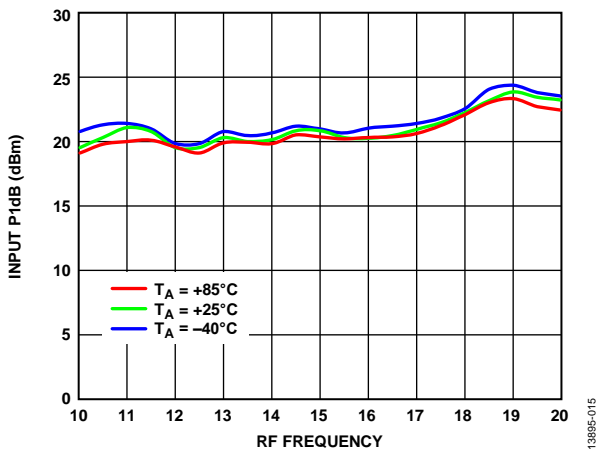


図 13. さまざまな温度での入力 P1dB と RF 周波数の関係 (LO = 13 dBm)

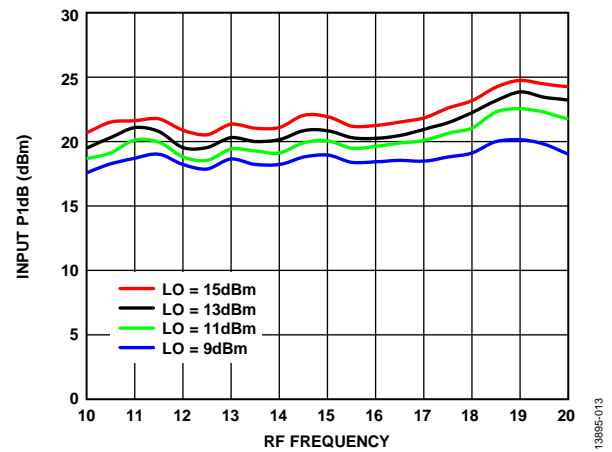


図 15. さまざまな LO パワー・レベルでの入力 P1dB と RF 周波数の関係 (TA = 25 °C)

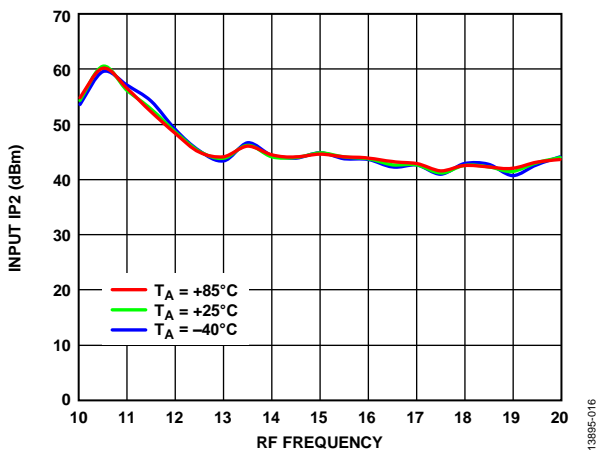


図 14. さまざまな温度での入力 IP2 と RF 周波数の関係 (LO = 13 dBm)

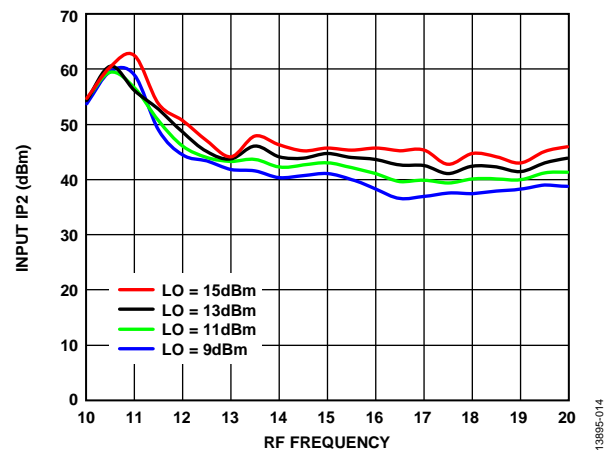


図 16. さまざまな LO パワー・レベルでの入力 IP2 と RF 周波数の関係 (TA = 25 °C)

下側波帯 (ハイサイド LO)

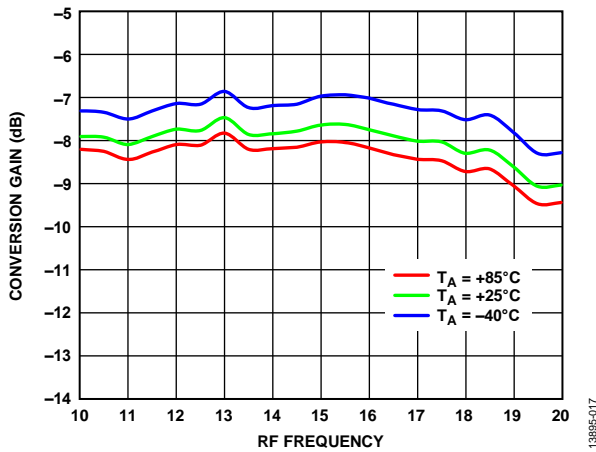


図 17. さまざまな温度での変換ゲインと RF 周波数の関係 (LO = 13 dBm)

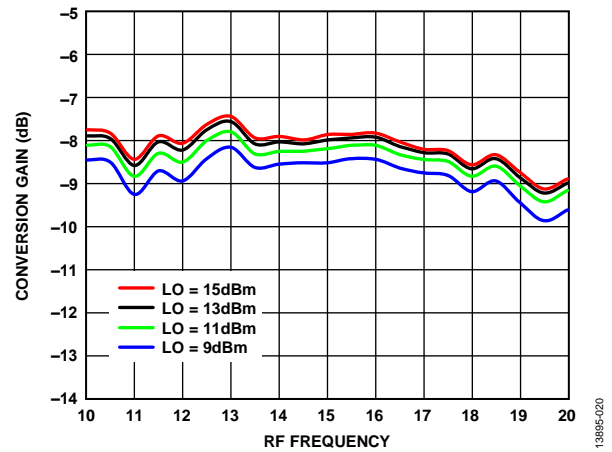


図 20. さまざまな LO パワー・レベルでの変換ゲインと RF 周波数の関係 ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

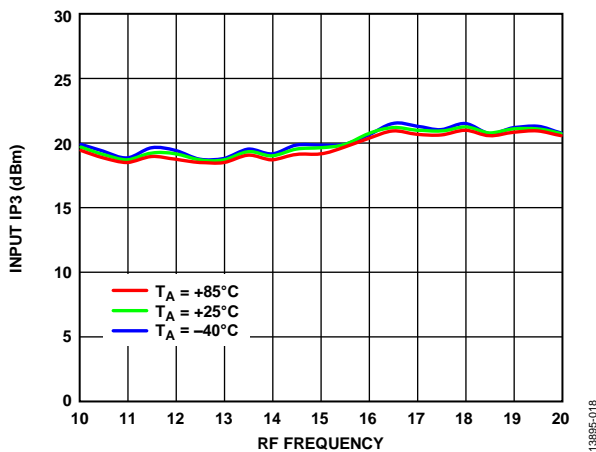


図 18. さまざまな温度での入力 IP3 と RF 周波数の関係 (LO = 13 dBm)

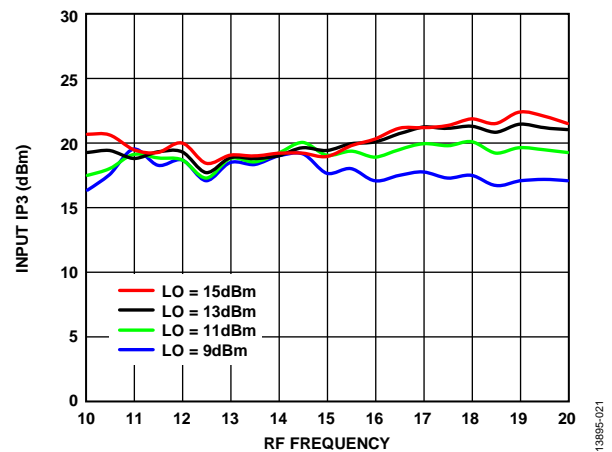


図 21. さまざまな LO パワー・レベルでの入力 IP3 と RF 周波数の関係 ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

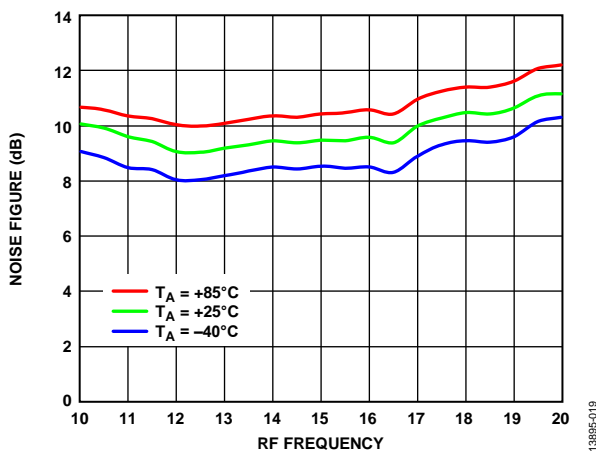


図 19. さまざまな温度でのノイズ指数と RF 周波数の関係 (LO = 13 dBm)

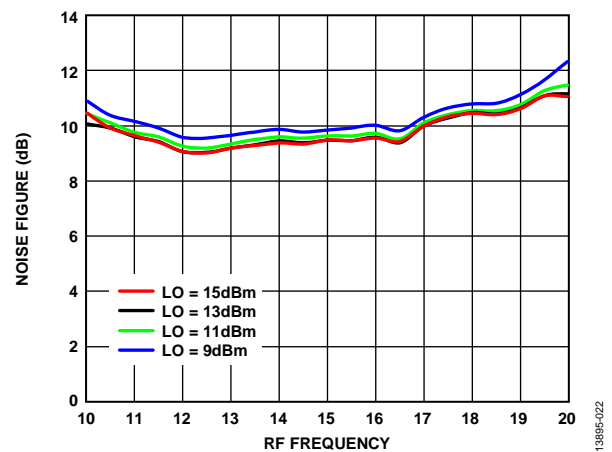


図 22. さまざまな LO パワー・レベルでのノイズ指数と RF 周波数の関係 ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

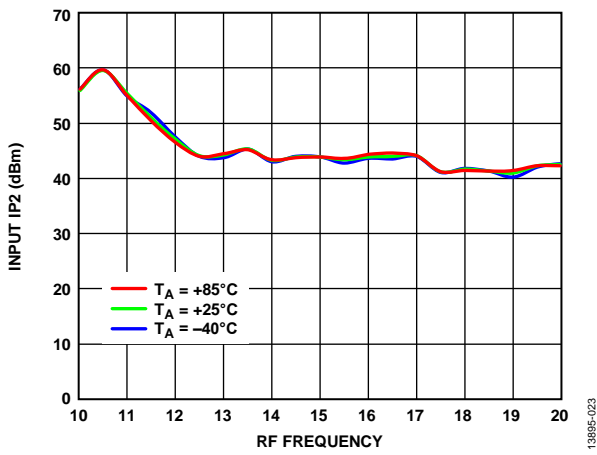


図 23. さまざまな温度での入力 IP2 と RF 周波数の関係 (LO = 13 dBm)

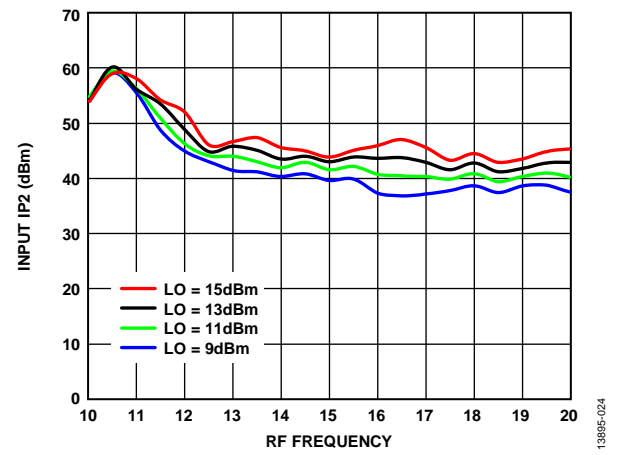


図 24. さまざまな LO パワー・レベルでの入力 IP2 と RF 周波数の関係 (TA = 25 °C)

ダウンコンバータの性能、IF = 3000 MHz
上側波帯 (ローサイド LO)

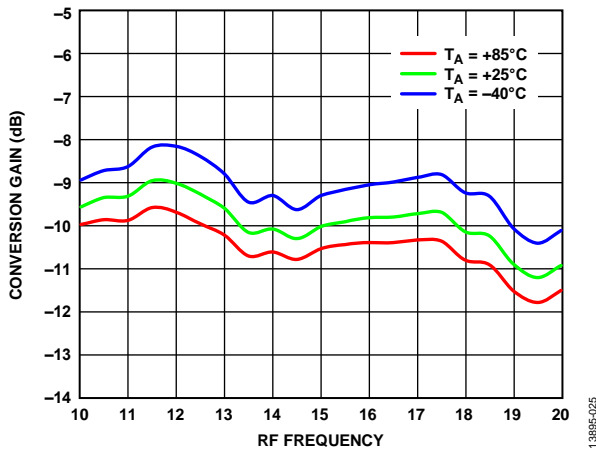


図 25. さまざまな温度での変換ゲインと RF 周波数の関係 (LO = 13 dBm)

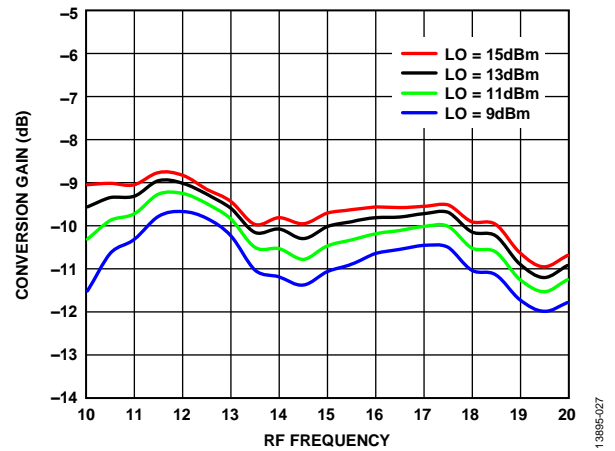


図 28. さまざまな LO パワー・レベルでの変換ゲインと RF 周波数の関係 (TA = 25 °C)

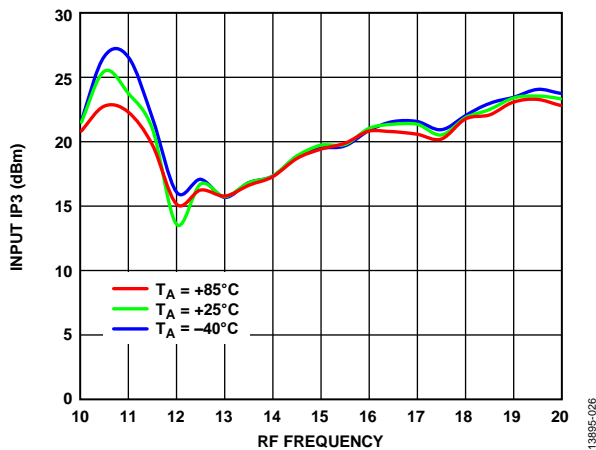


図 26. さまざまな温度での入力 IP3 と RF 周波数の関係 (LO = 13 dBm)

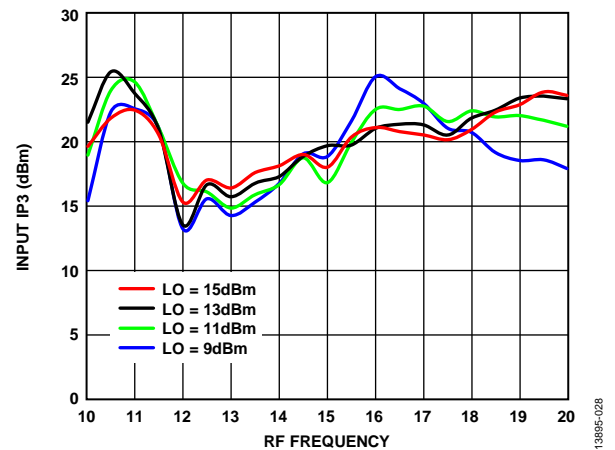


図 29. さまざまな LO パワー・レベルでの入力 IP3 と RF 周波数の関係 (TA = 25 °C)

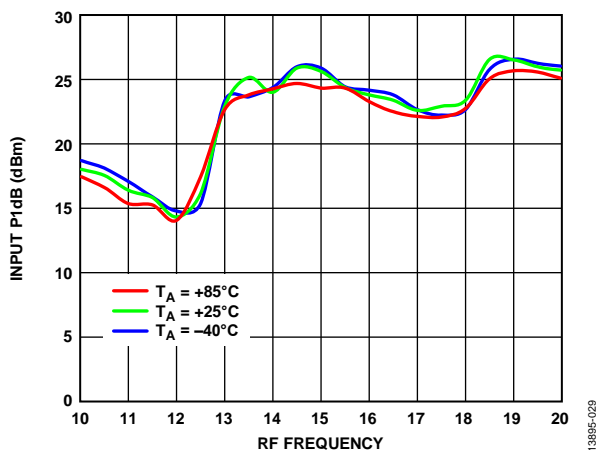


図 27. さまざまな温度での入力 P1dB と RF 周波数の関係 (LO = 13 dBm)

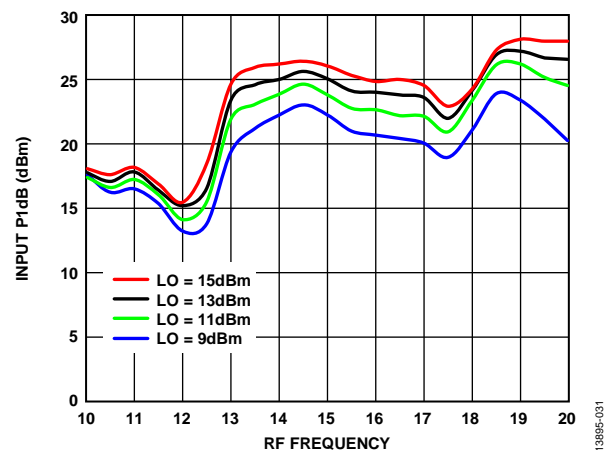


図 30. さまざまな LO パワー・レベルでの入力 P1dB と RF 周波数の関係 (TA = 25 °C)

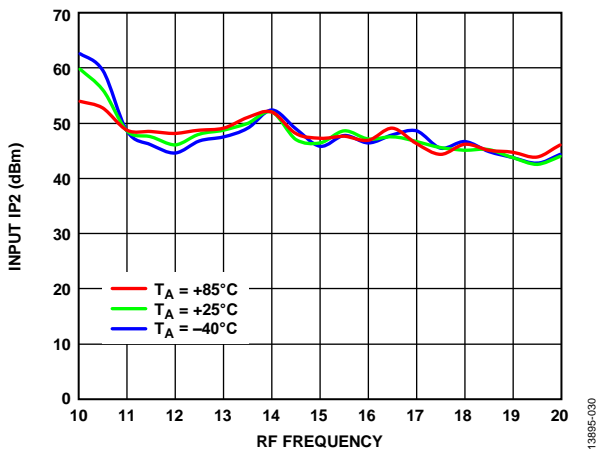


図 31. さまざまな温度での入力 IP2 と RF 周波数の関係 (LO = 13 dBm)

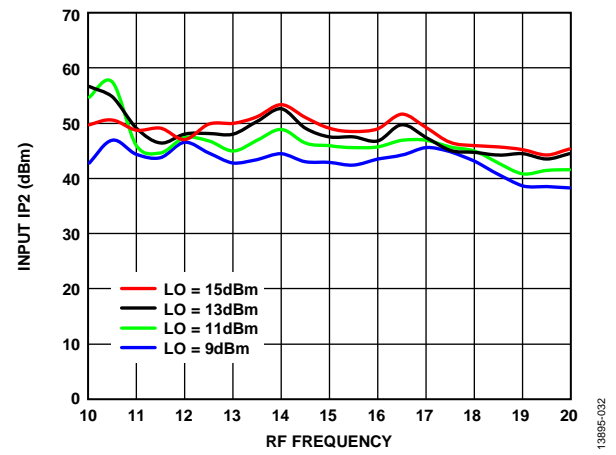


図 32. さまざまな LO パワー・レベルでの入力 IP2 と RF 周波数の関係 (TA = 25°C)

下側波帯 (ハイサイド LO)

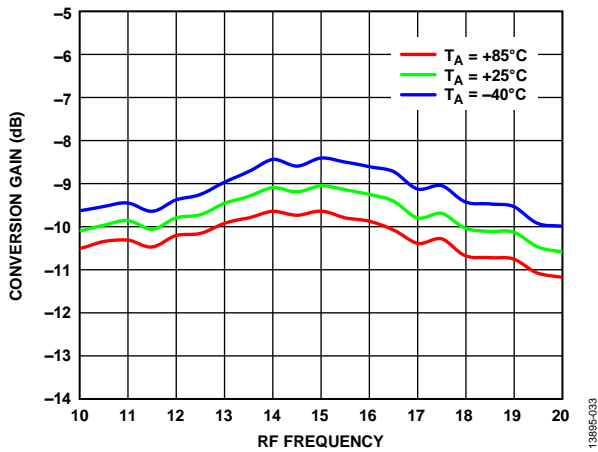


図 33. さまざまな温度での変換ゲインと RF 周波数の関係 (LO = 13 dBm)

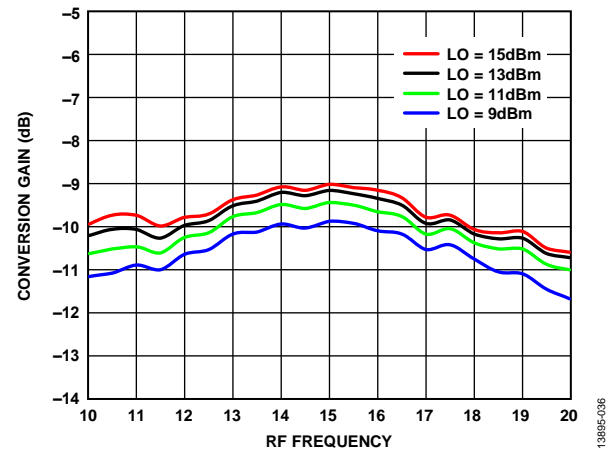


図 36. さまざまな LO パワー・レベルでの変換ゲインと RF 周波数の関係 (TA = 25 °C)

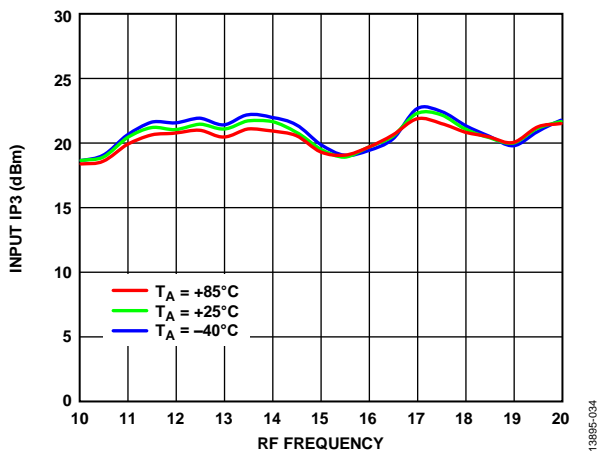


図 34. さまざまな温度での入力 IP3 と RF 周波数の関係 (LO = 13 dBm)

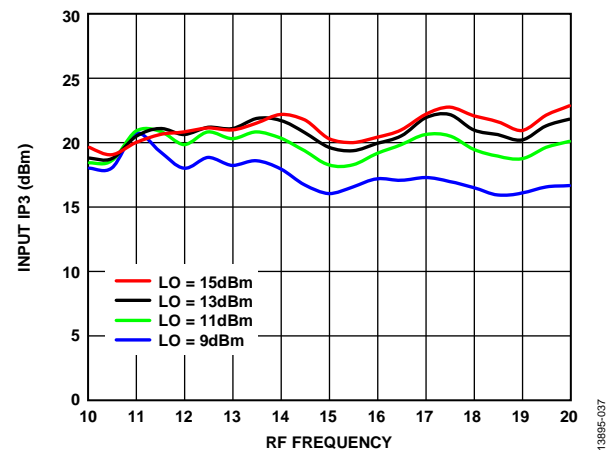


図 37. さまざまな LO パワー・レベルでの入力 IP3 と RF 周波数の関係 (TA = 25 °C)

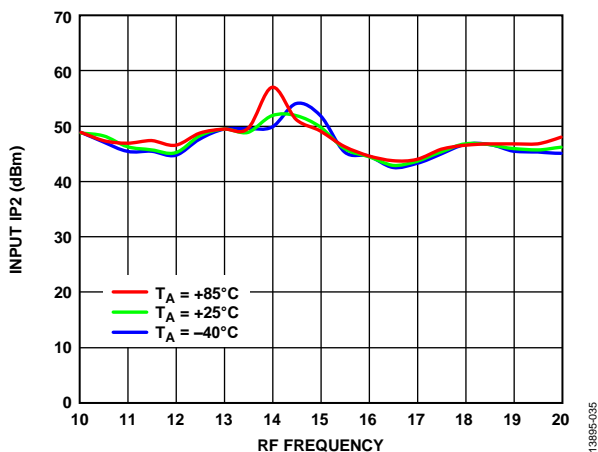


図 35. さまざまな LO パワー・レベルでの入力 IP2 と RF 周波数の関係 (TA = 25 °C)

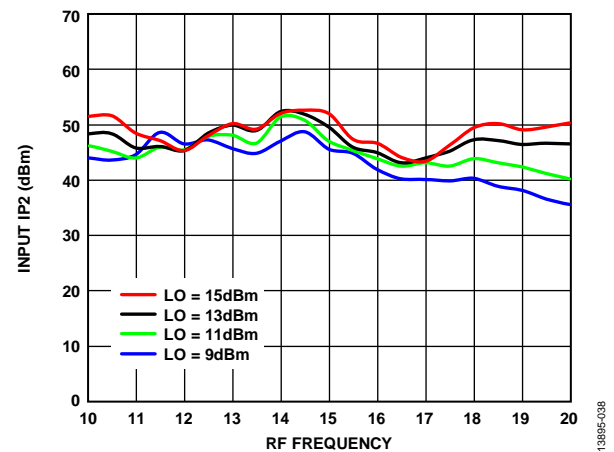


図 38. さまざまな LO パワー・レベルでの入力 IP2 と RF 周波数の関係 (TA = 25 °C)

アップコンバータの性能、 $IF_{IN} = 100\text{ MHz}$
上側波帯 (ローサイド LO)

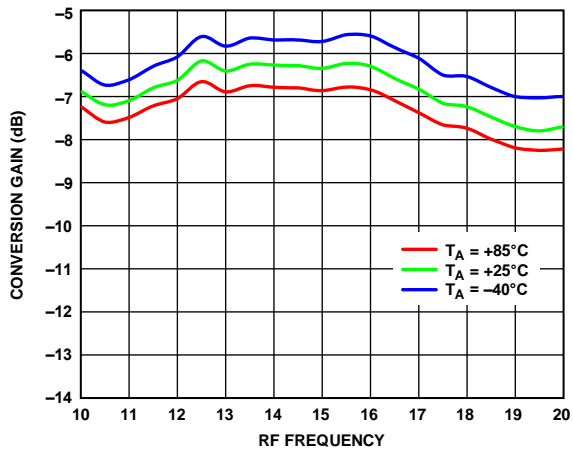


図 39. さまざまな温度での変換ゲインと RF 周波数の関係 (LO = 13 dBm)

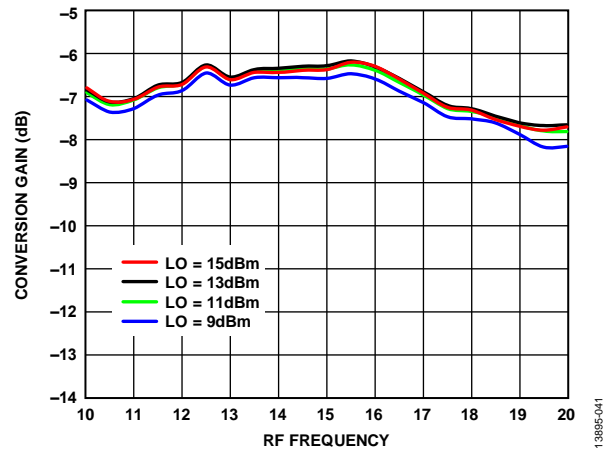


図 42. さまざまな LO パワー・レベルでの変換ゲインと RF 周波数の関係 ($T_A = 25\text{ }^\circ\text{C}$)

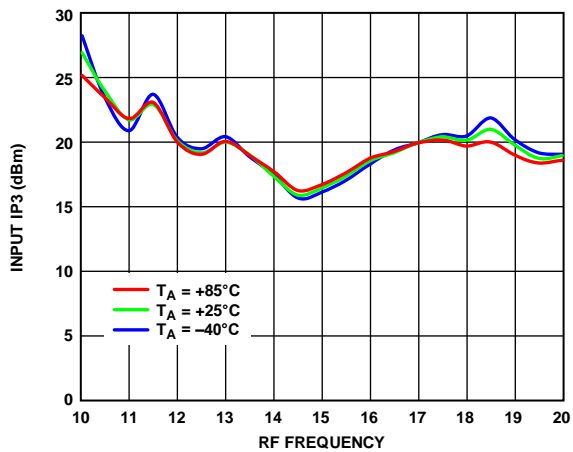


図 40. さまざまな温度での入力 IP3 と RF 周波数の関係 (LO = 13 dBm)

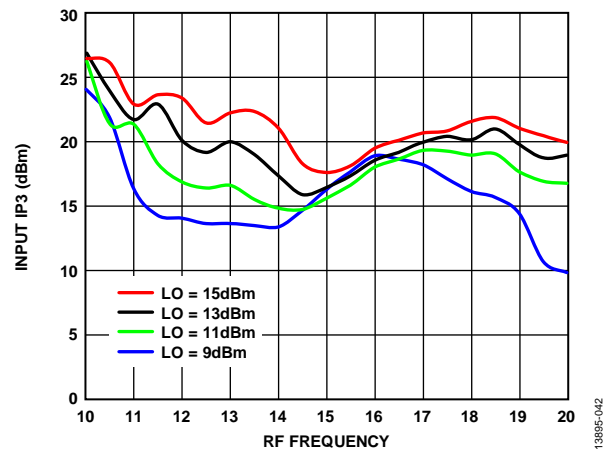


図 43. さまざまな LO パワー・レベルでの入力 IP3 と RF 周波数の関係 ($T_A = 25\text{ }^\circ\text{C}$)

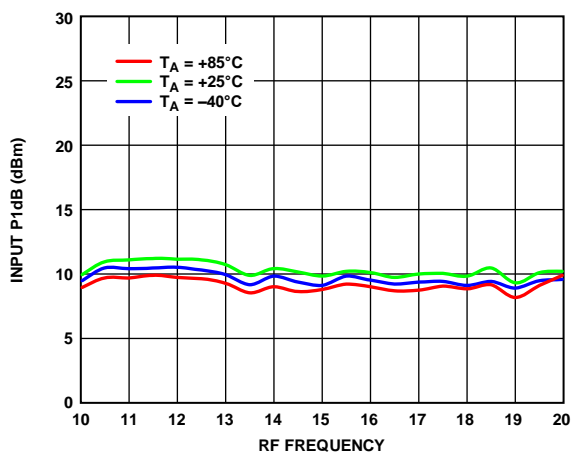


図 41. さまざまな温度での入力 P1dB と RF 周波数の関係 (LO = 13 dBm)

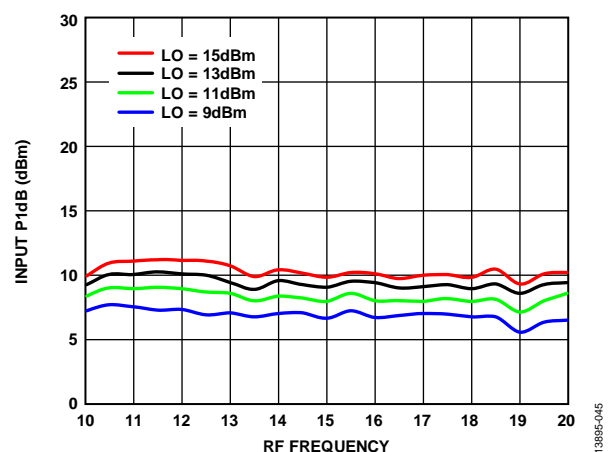


図 44. さまざまな LO パワー・レベルでの入力 P1dB と RF 周波数の関係 ($T_A = 25\text{ }^\circ\text{C}$)

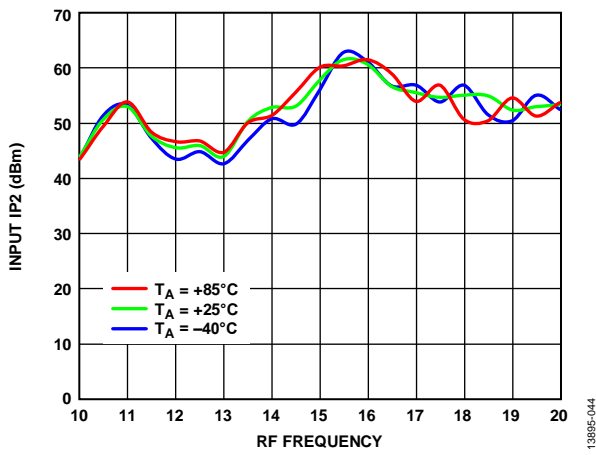


図 45. さまざまな温度での入力 IP2 と RF 周波数の関係 (LO = 13 dBm)

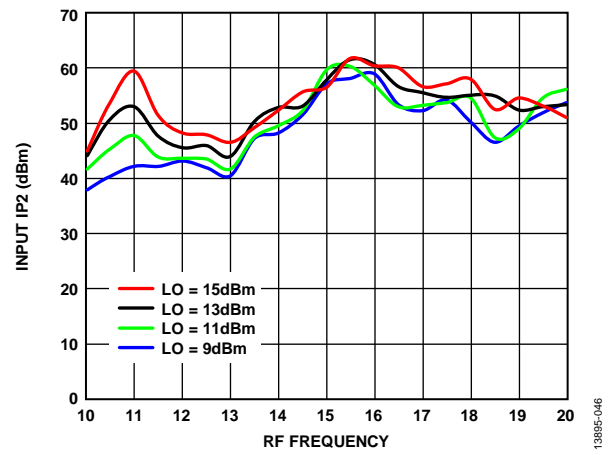


図 46. さまざまな LO パワー・レベルでの入力 IP2 と RF 周波数の関係 (TA = 25 °C)

下側波帯 (ハイサイド LO)

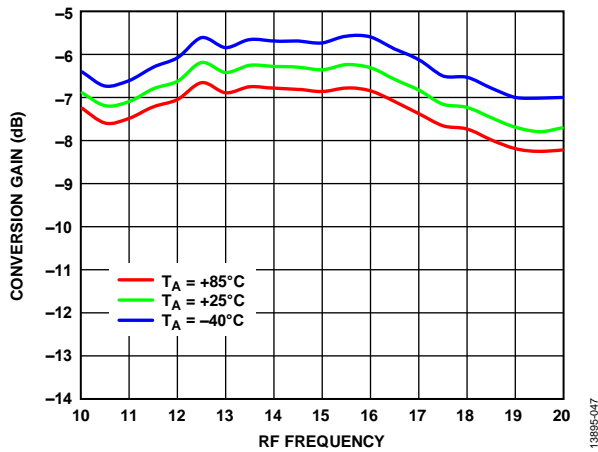


図 47. さまざまな温度での変換ゲインと RF 周波数の関係 (LO = 13 dBm)

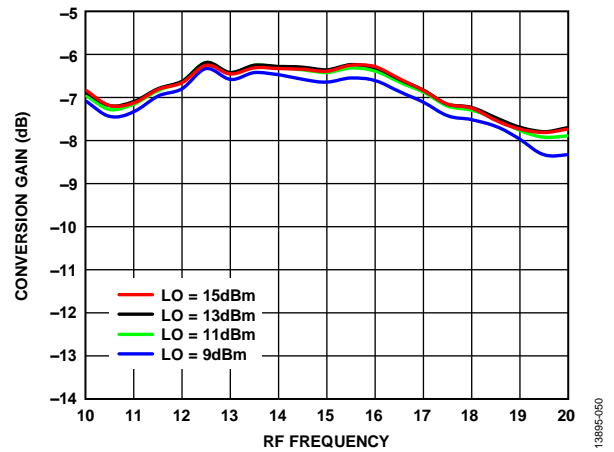


図 50. さまざまな LO パワー・レベルでの変換ゲインと RF 周波数の関係 (TA = 25 °C)

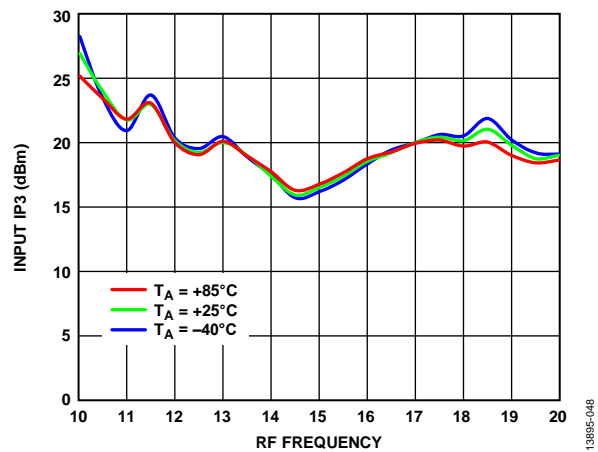


図 48. さまざまな温度での入力 IP3 と RF 周波数の関係 (LO = 13 dBm)

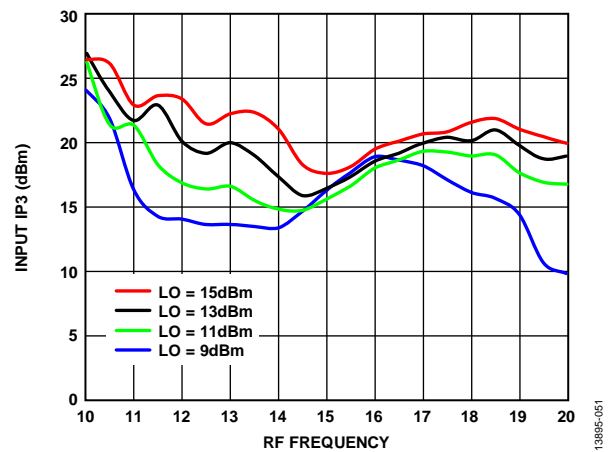


図 51. さまざまな LO パワー・レベルでの入力 IP3 と RF 周波数の関係 (TA = 25 °C)

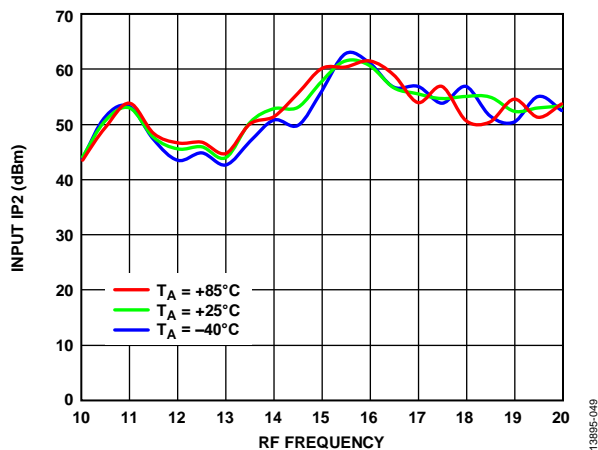


図 49. さまざまな温度での入力 IP2 と RF 周波数の関係 (LO = 13 dBm)

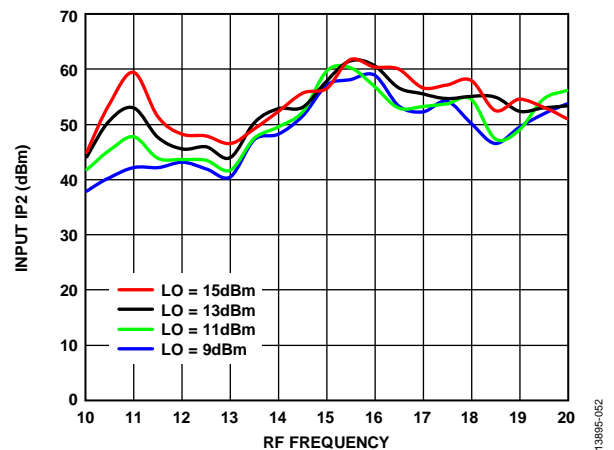


図 52. さまざまな LO パワー・レベルでの入力 IP2 と RF 周波数の関係 (TA = 25 °C)

アップコンバータの性能、 $IF_{IN} = 3000$ MHz
上側波帯 (ローサイド LO)

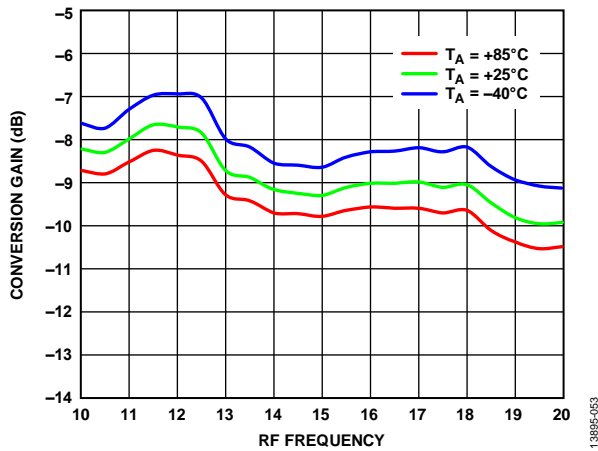


図 53. さまざまな温度での変換ゲインと RF 周波数の関係 (LO = 13 dBm)

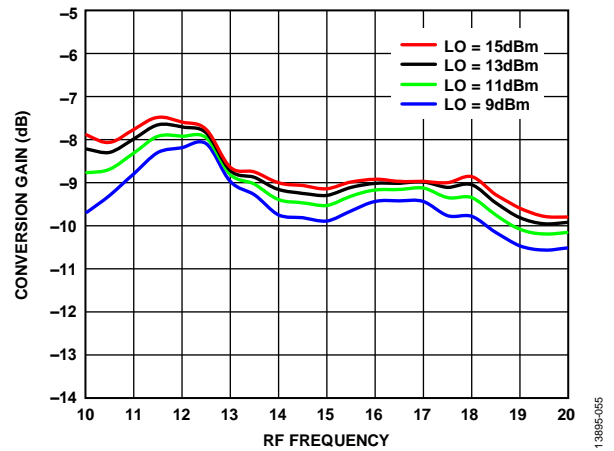


図 56. さまざまな LO パワー・レベルでの変換ゲインと RF 周波数の関係 ($T_A = 25$ °C)

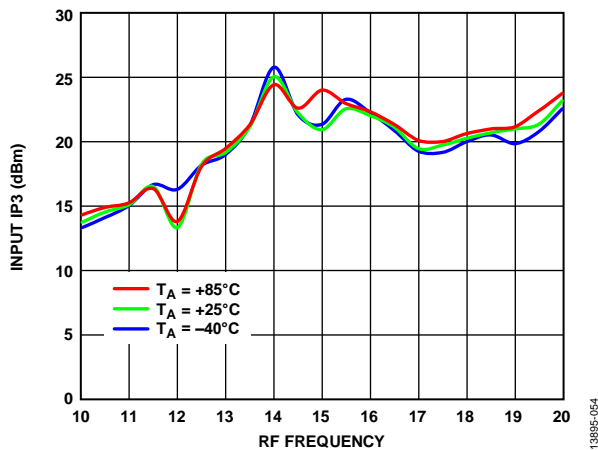


図 54. さまざまな温度での入力 IP3 と RF 周波数の関係 (LO = 13 dBm)

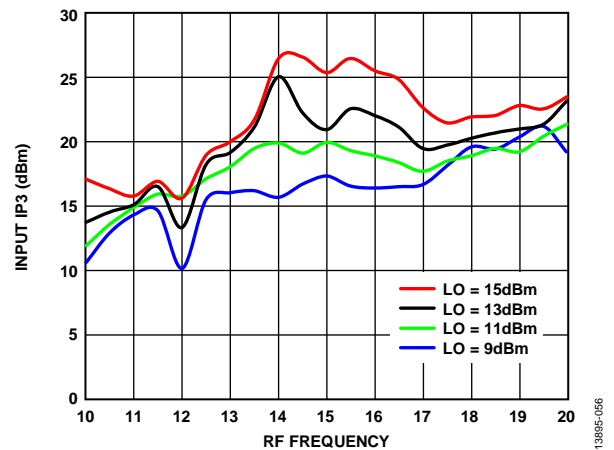


図 57. さまざまな LO パワー・レベルでの入力 IP3 と RF 周波数の関係 ($T_A = 25$ °C)

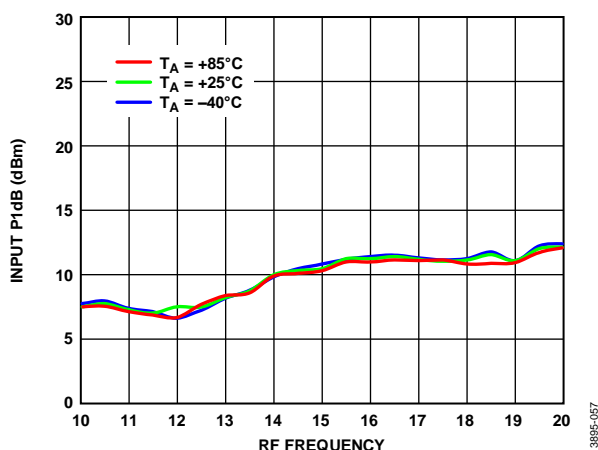


図 55. さまざまな温度での入力 P1dB と RF 周波数の関係 (LO = 13 dBm)

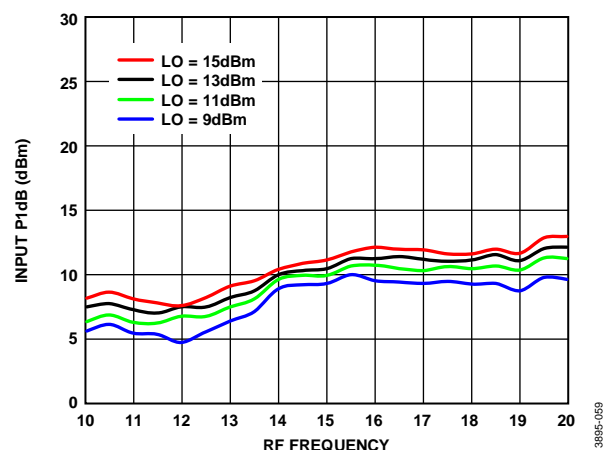


図 58. さまざまな LO パワー・レベルでの入力 P1dB と RF 周波数の関係 ($T_A = 25$ °C)

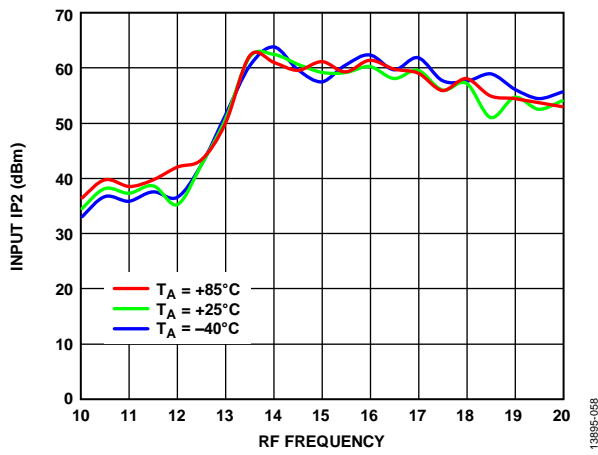


図 59. さまざまな温度での入力 IP2 と RF 周波数の関係 (LO = 13 dBm)

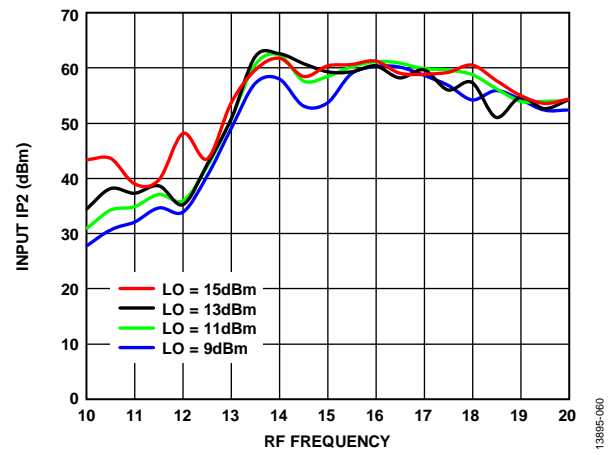


図 60. さまざまな LO パワー・レベルでの入力 IP2 と RF 周波数の関係 (TA = 25 °C)

下側波帯 (ハイサイド LO)

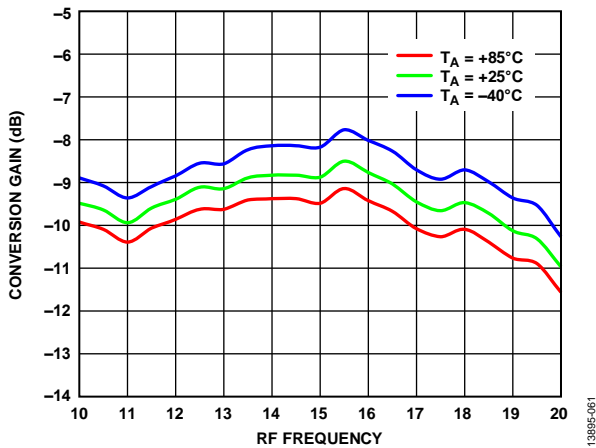


図 61. さまざまな温度での変換ゲインと RF 周波数の関係 (LO = 13 dBm)

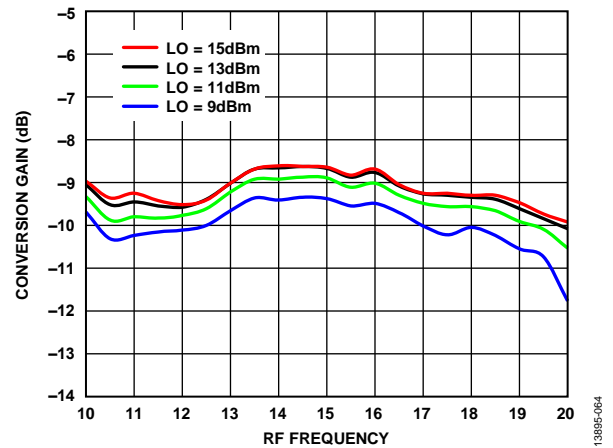


図 64. さまざまな LO パワー・レベルでの変換ゲインと RF 周波数の関係 (TA = 25°C)

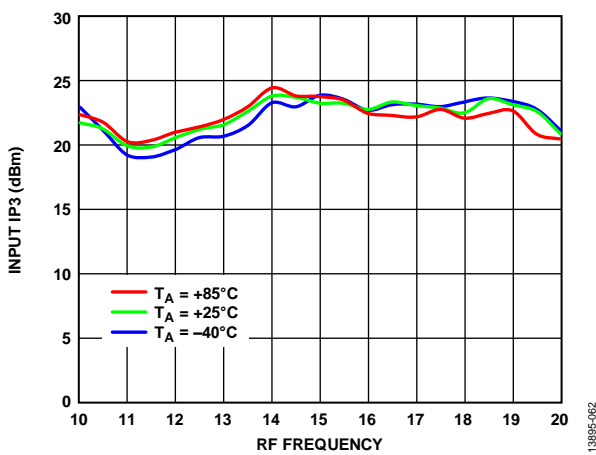


図 62. さまざまな温度での入力 IP3 と RF 周波数の関係 (LO = 13 dBm)

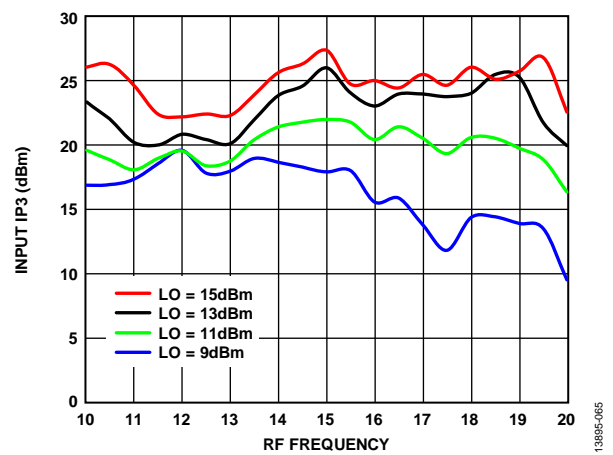


図 65. さまざまな LO パワー・レベルでの入力 IP3 と RF 周波数の関係 (TA = 25°C)

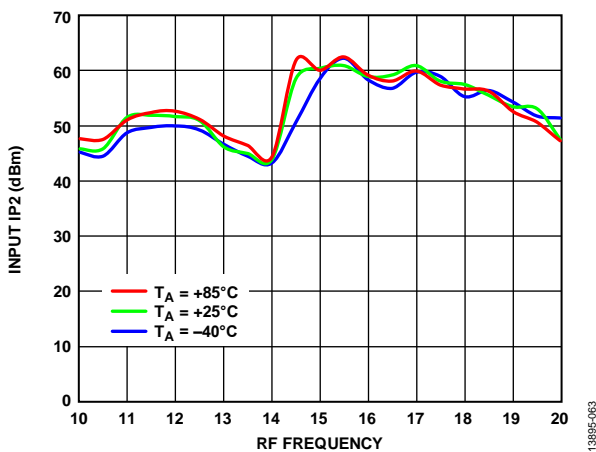


図 63. さまざまな温度での入力 IP2 と RF 周波数の関係 (LO = 13 dBm)

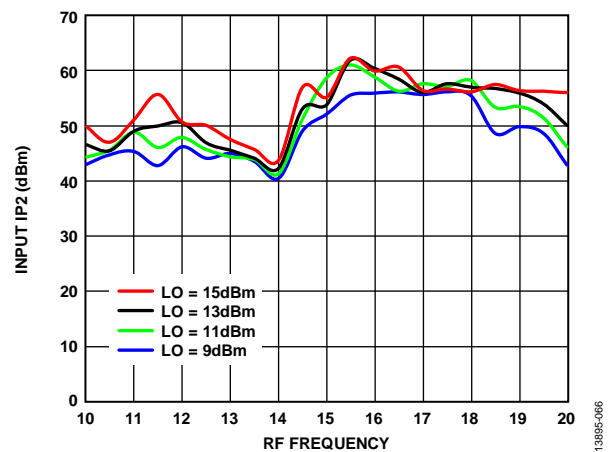
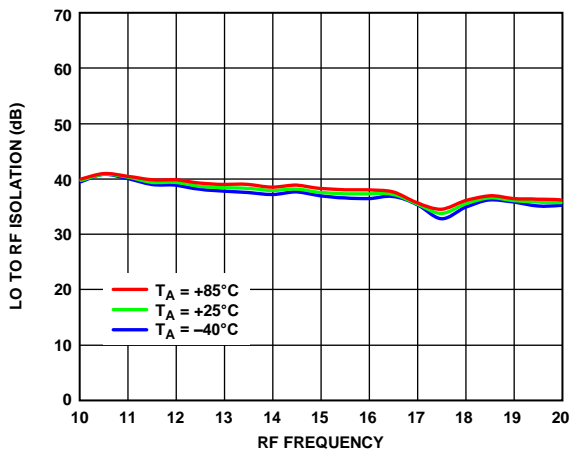


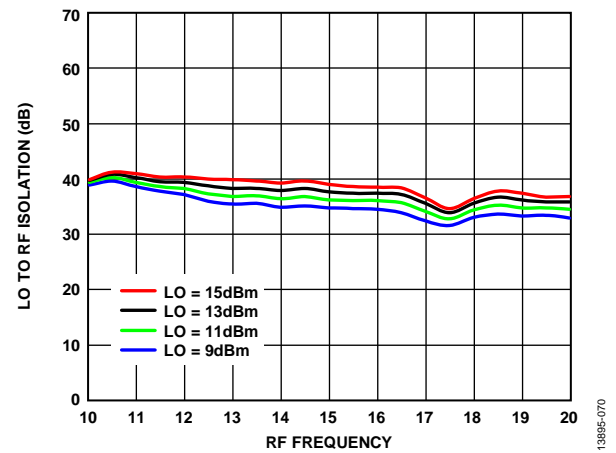
図 66. さまざまな LO パワー・レベルでの入力 IP2 と RF 周波数の関係 (TA = 25°C)

アイソレーションおよびリターン・ロス



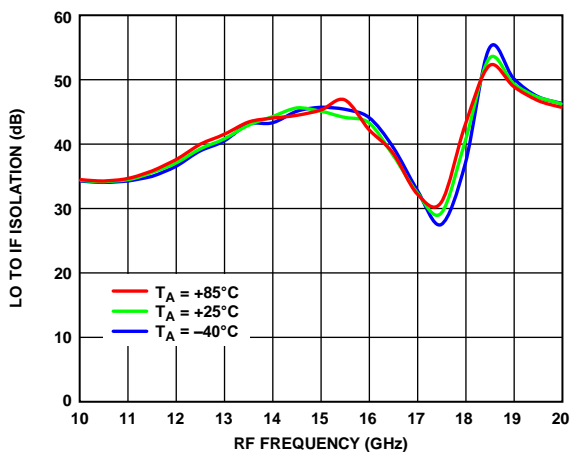
13895-067

図 67. さまざまな温度での LO/RF アイソレーションと RF 周波数の関係 (LO = 13 dBm)



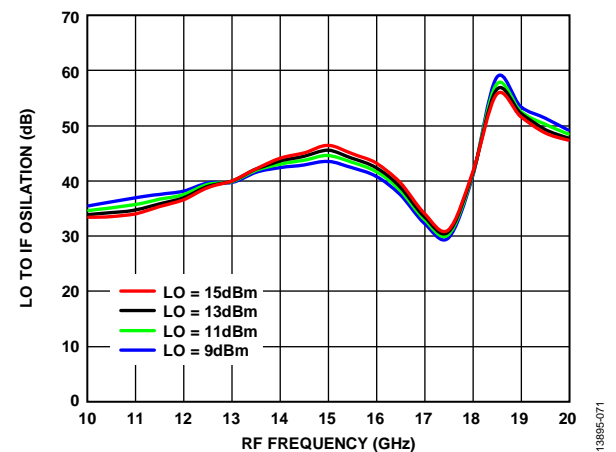
13895-070

図 70. さまざまな LO パワー・レベルでの LO/RF アイソレーションと RF 周波数の関係 (TA = 25°C)



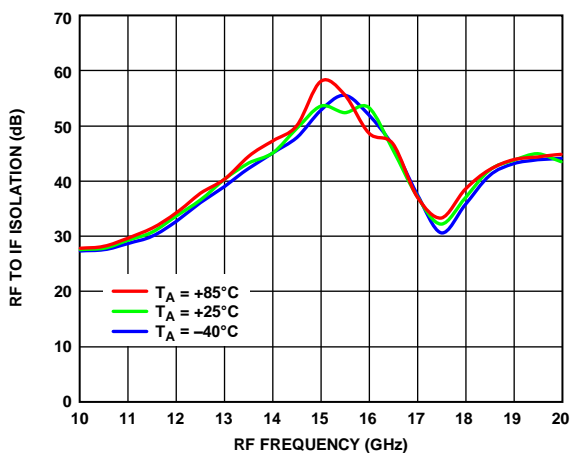
13895-068

図 68. さまざまな温度での LO/IF アイソレーションと RF 周波数の関係 (LO = 13 dBm)



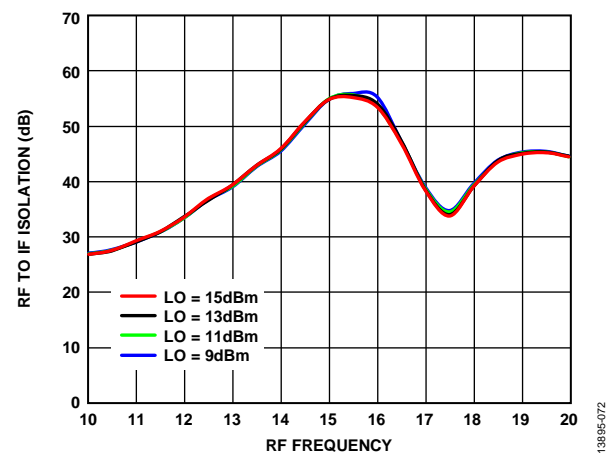
13895-071

図 71. さまざまな LO パワー・レベルでの LO/IF アイソレーションと RF 周波数の関係 (TA = 25°C)



13895-069

図 69. さまざまな温度での RF/IF アイソレーションと RF 周波数の関係 (LO = 13 dBm)



13895-072

図 72. さまざまな LO パワー・レベルでの RF/IF アイソレーションと RF 周波数の関係 (TA = 25°C)

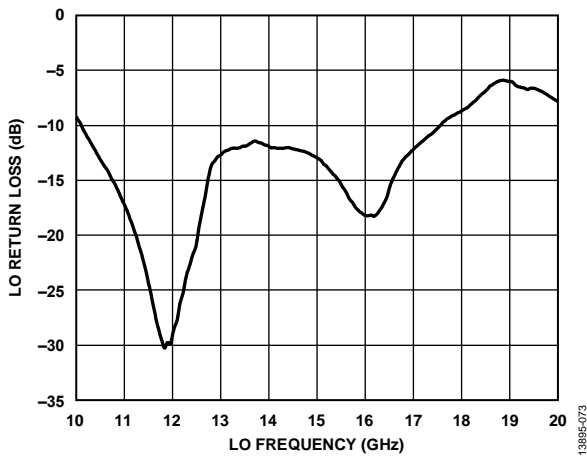


図 73. LO = 13 dBm での LO リターン・ロスと LO 周波数の関係 (T_A = 25°C)

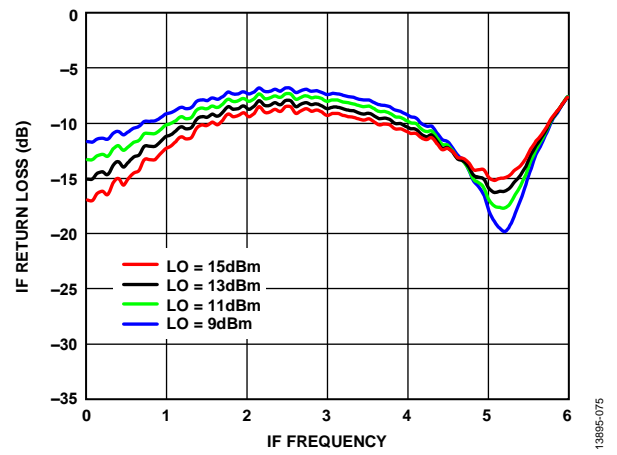


図 75. さまざまな LO パワー・レベルでの IF リターン・ロスと IF 周波数の関係 (T_A = 25°C、LO = 15 GHz)

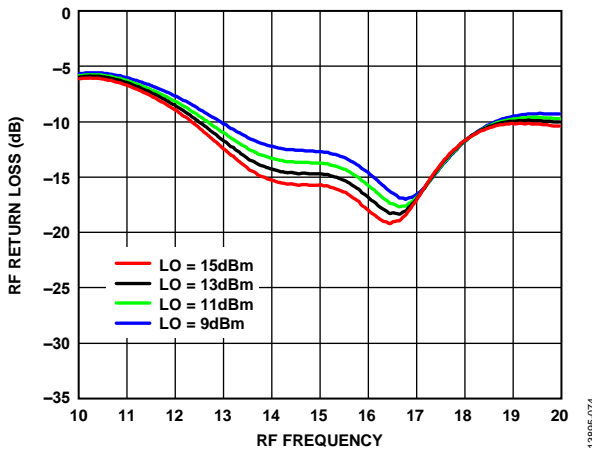


図 74. さまざまな LO パワー・レベルでの RF リターン・ロスと RF 周波数の関係, (T_A = 25°C、LO = 15 GHz)

IF 帯域幅 - ダウンコンバータ
上側波帯、LO 周波数 = 12 GHz

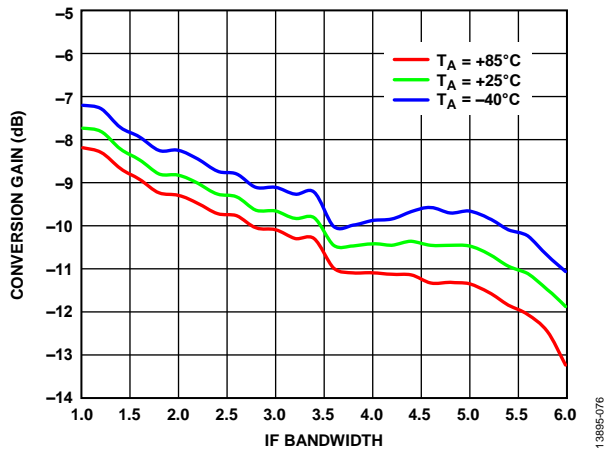


図 76. さまざまな温度での変換ゲインと IF 周波数の関係 (LO = 13 dBm)

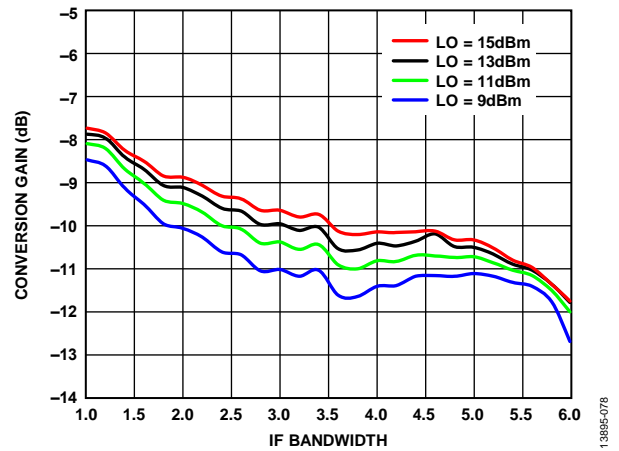


図 78. さまざまな LO パワー・レベルでの変換ゲインと IF 周波数の関係 (TA = 25°C)

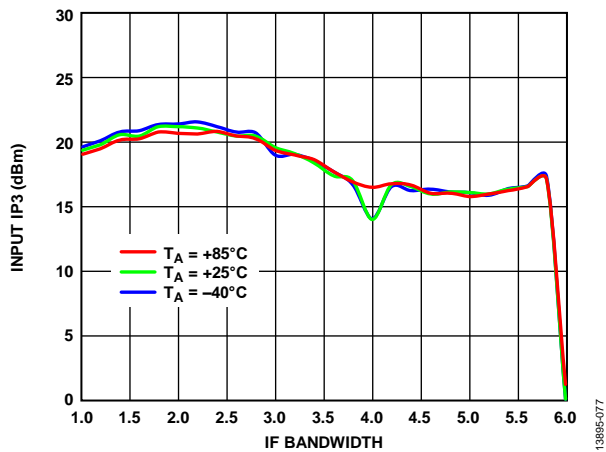


図 77. さまざまな温度での入力 IP3 と IF 周波数の関係 (LO = 13 dBm)

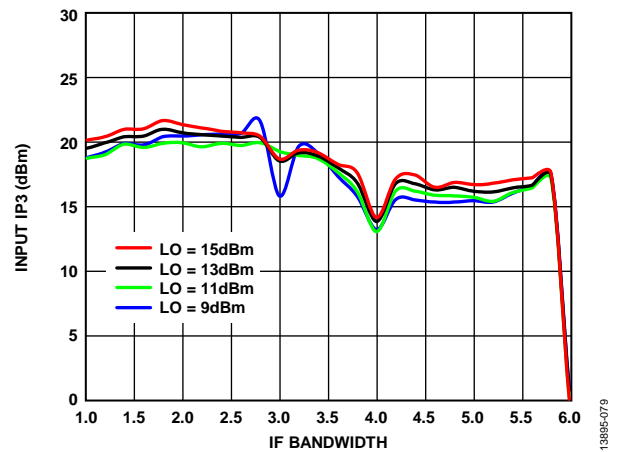


図 79. さまざまな LO パワー・レベルでの入力 IP3 と IF 周波数の関係 (TA = 25°C)

下側波帯、LO 周波数 = 19 GHz

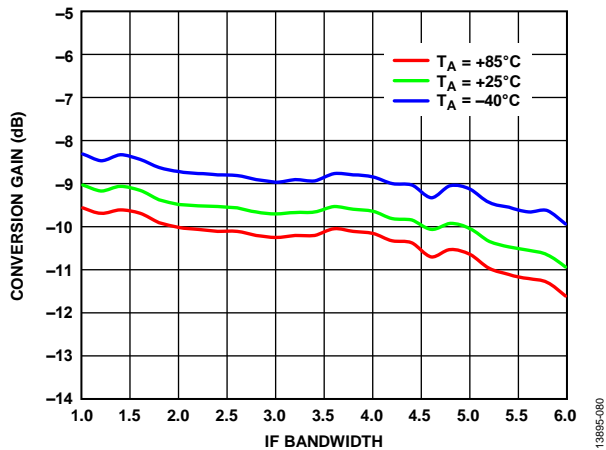


図 80. さまざまな温度での変換ゲインと IF 周波数の関係 (LO = 13 dBm)

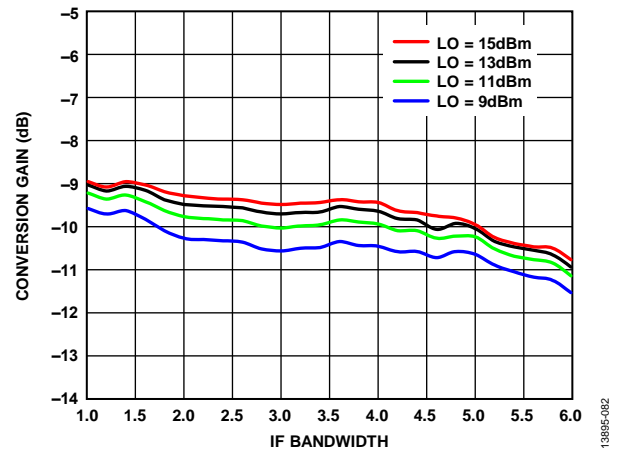


図 82. さまざまな LO パワー・レベルでの変換ゲインと IF 周波数の関係 (TA = 25°C)

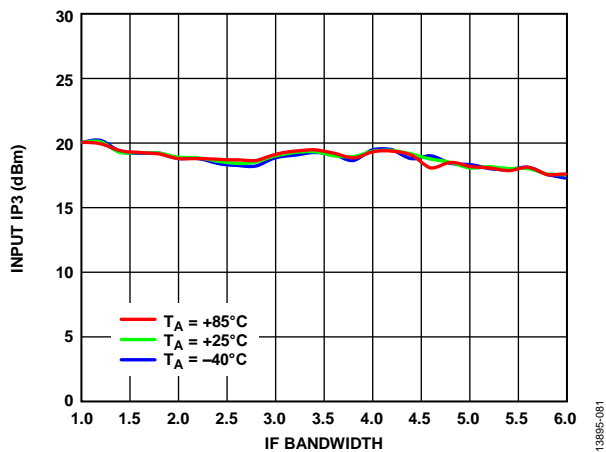


図 81. さまざまな温度での入力 IP3 と IF 周波数の関係 (LO = 13 dBm)

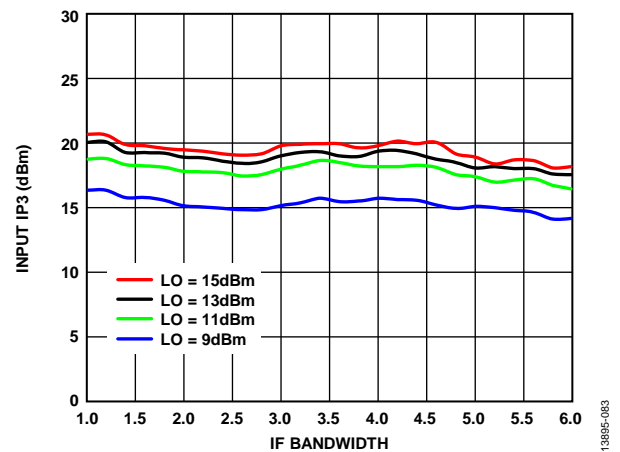


図 83. さまざまな LO パワー・レベルでの入力 IP3 と IF 周波数の関係 (TA = 25°C)

スプリアスおよび高調波性能

ミキサースプリアス積は、IF 出力パワー・レベルをどれだけ下回るかを dBc を単位として測定したもの。N/A は該当なしを表します。

LO 高調波

LO = 13 dBm。すべての値は、入力 LO レベルをどれだけ下回るかを dBc を単位として表したもので、RF ポートでの測定値。

表 5. RF での LO 高調波

LO Frequency (GHz)	N × LO Spur at RF Port			
	1	2	3	4
12	39	39	59	57
13	38	40	70	N/A
15	38	48	49	N/A
16	37	56	50	N/A
18	36	54	N/A	N/A
19	36	53	N/A	N/A
21	36	46	N/A	N/A

LO = 13 dBm。すべての値は入力 LO レベルをどれだけ下回るかを dBc を単位として表したもので、IF ポートでの測定値。

表 6. IF での LO 高調波

LO Frequency (GHz)	N × LO Spur at IF Port			
	1	2	3	4
12	38	77	67	89
13	41	63	74	N/A
15	44	72	56	N/A
16	42	53	56	N/A
18	44	79	N/A	N/A
19	53	70	N/A	N/A
21	47	75	N/A	N/A

M × N スプリアス出力

ダウンコンバータ、上側波帯

スプリアスの値は(M × RF) - (N × LO)の場合のもの。

RF = 15.1 GHz (-10 dBm)、LO = 15 GHz (13 dBm)。

		N × LO					
		0	1	2	3	4	5
M × RF	0	N/A	14	47	27	N/A	N/A
	1	48	0	70	72	65	N/A
	2	75	77	60	79	74	68
	3	65	74	79	70	78	71
	4	N/A	60	74	80	88	78
	5	N/A	N/A	56	72	81	88

アップコンバータ、上側波帯

スプリアスの値は(M × IF) + (N × LO)の場合のもの。

IF_{IN} = 100 MHz (-10 dBm)、LO = 15 GHz (13 dBm)。

		N × LO			
		0	1	2	3
M × IF	-5	89	80	73	67
	-4	88	79	73	68
	-3	91	66	74	66
	-2	91	67	74	66
	-1	36	0	35	20
	0	N/A	6	17	22
	+1	36	0	35	19
	+2	88	63	73	65
	+3	90	63	74	66
	+4	90	80	73	65
	+5	88	78	72	66

動作原理

HMC554ALC3B は汎用二重平衡ミキサーで、10 GHz ~ 20 GHz のアップコンバータまたはダウンコンバータとして使用することができます。

ダウンコンバータとして使用する場合、HMC554ALC3B は 10 GHz ~ 20 GHz の無線周波数 (RF) を DC ~ 6 GHz の中間周波数 (IF) にダウンコンバートします。

アップコンバータとして使用する場合、このミキサーは、DC ~ 6 GHz の中間周波数を 10 GHz ~ 20 GHz の無線周波数にアップコンバートします。

アプリケーション情報

代表的なアプリケーション回路

HMC554ALC3Bの代表的なアプリケーション回路を図84に示します。HMC554ALC3Bはパッシブ・デバイスで、外付け部品は一切不要です。IFピンは内部でDCカップリングされており、RFピンとLOピンは内部でACカップリングされています。DCまでのIF動作が不要な場合、必要なIF周波数範囲を通過させるように値を選択したコンデンサを直列に外付けすることをお奨めします。DCまでのIF動作が必要な場合は、絶対最大定格のセクションで規定されたIFのソース電流とシンク電流の定格を超えないようにしてください。

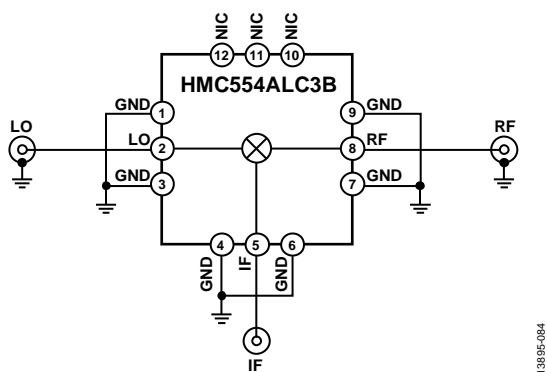


図 84. 代表的なアプリケーション回路

評価用 PCB の情報

アプリケーションで使用する回路基板には、RF回路設計手法を適用してください。信号線のインピーダンスは50Ωとし、パッケージのグラウンド・ピンと露出パッドは必ずグラウンド・プレーンに直接接続してください(図84参照)。上面と底面のグラウンド・プレーンを接続する場合は、十分な数のビア・ホールを使用してください。図85に示す評価用回路ボードは、ご要望に応じてアナログ・デバイセズから入手できます。

表 7. 評価用 PCB EV1HMC554ALC3B の部品表

Item	Description
J1, J2	PCB mount SRI 2.92 mm connectors
J3	PCB mount Johnson SMA connector
U1	HMC554ALC3B
PCB ¹	117611-1 evaluation board on Rogers 4350

¹ 117611-1 は未加工のベア PCB の識別番号です。フル機能の評価用 PCB を注文する場合は EV1HMC554ALC3B を参照してください。

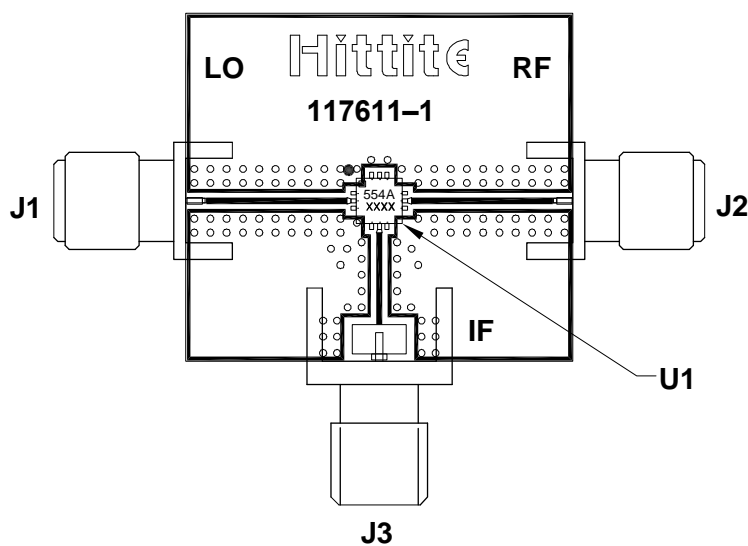


図 85. 評価用 PCB の上面層

外形寸法

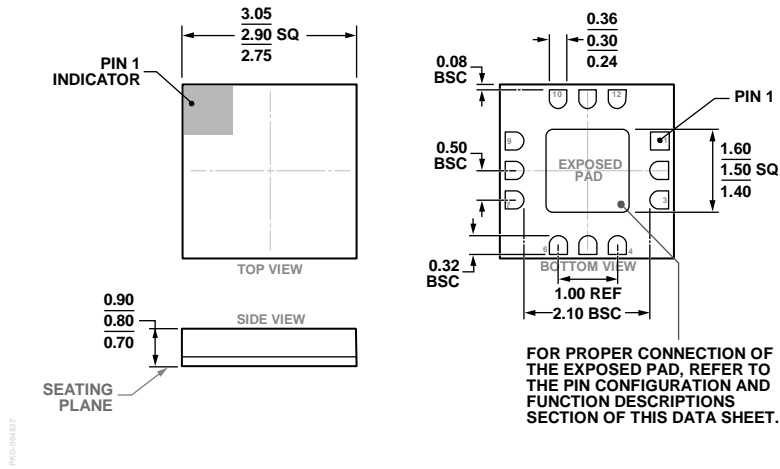


図 86. 12 端子セラミック・リードレス・チップ・キャリア (LCC)
(E-12-4)
寸法: mm

オーダー・ガイド

Model ¹	Temperature Range	MSL Rating ²	Package Description	Package Option
HMC554ALC3B	-40°C to +85°C	MSL3	12-Terminal LCC	E-12-4
HMC554ALC3BTR	-40°C to +85°C	MSL3	12-Terminal LCC	E-12-4
HMC554ALC3BTR-R5	-40°C to +85°C	MSL3	12-Terminal LCC	E-12-4
EV1HMC554ALC3B			Evaluation PCB Assembly	

¹ すべてのモデルは RoHS 準拠製品です。

² ピーク・リフロー温度は 260 °C です。絶対最大定格のセクションの表 2 を参照してください。